

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2006 年 6 月 15 日 (15.06.2006)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2006/061879 A1

- (51) 国際特許分類⁷: H01L 25/00, B60R 21/32, F42B 3/13
(21) 国際出願番号: PCT/JP2004/018168
(22) 国際出願日: 2004 年 12 月 6 日 (06.12.2004)
(25) 国際出願の言語: 日本語
(26) 国際公開の言語: 日本語
(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 株式会社ルネサステクノロジ (RENESAS TECHNOLOGY CORP.) [JP/JP]; 〒1006334 東京都千代田区丸の内二丁目 4 番 1 号 Tokyo (JP).
(72) 発明者; および
(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): ▲高▼橋 靖司 (TAKAHASHI, Yasushi) [JP/JP]; 〒1006334 東京都千代田区丸の内二丁目 4 番 1 号 株式会社ルネサステクノロジ内 Tokyo (JP).

(74) 代理人: 秋田 収喜 (AKITA, Shuki); 〒1140013 東京都北区東田端 1 丁目 1 3 番 9 号 ツインビル田端 B 2 階 Tokyo (JP).

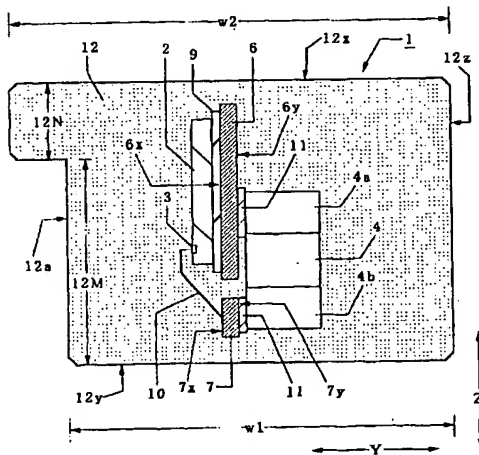
(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AF, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ,

[続葉有]

(54) Title: IGNITER, SEMICONDUCTOR DEVICE AND MANUFACTURING METHOD THEREOF

(54) 発明の名称: 点火装置、半導体装置及びその製造方法



(57) Abstract: A semiconductor device (1) is built in an igniter incorporated in a gas generating apparatus for an air bag apparatus. The semiconductor device (1) has a package structure using a lead frame, a semiconductor chip (communication device, 2) is arranged on the main side of a supporting body (6), and a capacitor element (capacitor for igniter, 4) is arranged on a rear side opposite to the main side of the supporting body. Size reduction, manufacturing cost reduction and high reliabilities of the semiconductor device and the igniter are attained.

(57) 要約:

半導体装置 (1) はエアバッグ装置のガス発生装置に組み込まれた点火装置に内蔵されている。半導体装置 (1) はリードフレームを用いたパッケージ構造とされ、支持体 (6) の主面側に半導体チップ (通信デバイス、2) を配置し、前記支持体の主面と反対側の裏面側に容量素子 (点火用のコンデンサ、4) を配置する。このような構成にすることにより、半導体装置及び点火装置の小型化、製造コストの低減化、及び高信頼度化を図ることができる。

WO 2006/061879 A1



BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

添付公開書類:

— 国際調査報告書